

Photodiode JE 4,8-G



- Charakteristik :**
- ◆ integriertes Grünfilter
 - ◆ strahlungsempfindliche Fläche (2,2x2,2) 4,8 mm²
 - ◆ hochwertige Si - PIN - Photodiode mit niedrigem Dunkelstromniveau, hohem Nullpunkt-widerstand
 - ◆ hermetisches TO39 - Gehäuse

- Applikationen :**
- ◆ Detektor für lichttechnische Anwendungen
 - ◆ Farbmestechnik

Grenzwerte:

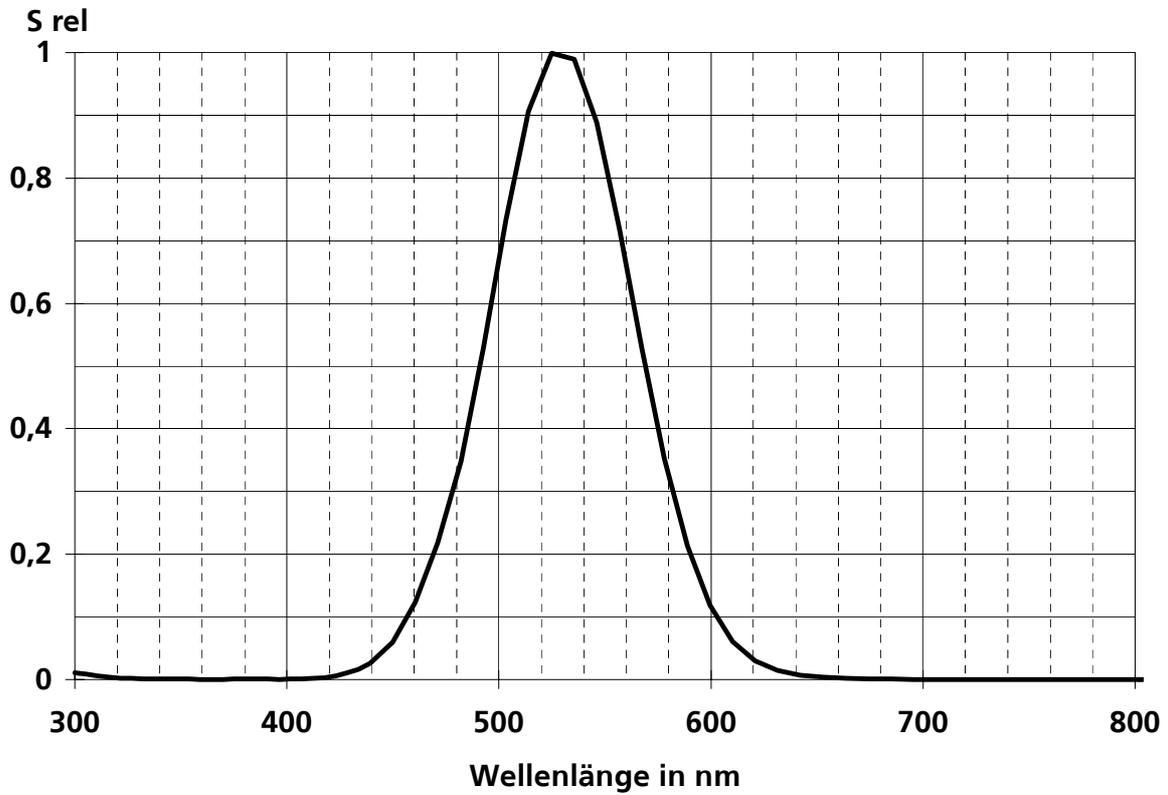
Sperrspannung	20	V
Betriebstemperaturbereich	- 25 °C ... 70	°C
Lagertemperaturbereich	0 °C ... 100	°C
Löttemperatur (3s)	260	°C

Technische Daten :

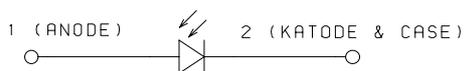
Allgemeine Meßbedingungen, sofern nicht anders spezifiziert: $\gamma_a = 25\text{ °C}$, $V_R = 0V$

Parameter	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einh.
strahlungsempfindliche Fläche			4,8		mm ²
Max. der spektralen Empfindlichkeit S_{max} bei			530		nm
Halbwertsbreite	$S = 0,5 \cdot S_{max}$		80		nm
absolute spektrale Empfindlichkeit	$\lambda = 530\text{ nm}$		0,09		A/W
Dunkelstrom I_R	$V_R = 10\text{ V}, E = 0\text{ lx}$		2	20	nA
Anstiegszeit Abfallzeit des Fotostromes	$R_L = 1\text{ k}\Omega$ $\lambda = 830\text{ nm}$ $V_R = 5\text{ V}$ $I_p = 20\text{ }\mu\text{A}$		150		ns
Kapazität	$f = 1\text{ Mhz}$ $E = 0\text{ lx}, V_R = 0V$ $E = 0\text{ lx}, V_R = 20V$		50 8		pF

relative spektrale Empfindlichkeit



Anschlußbelegung



Gehäuseabmessungen,

